

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЛАСТЕЙ E, F1, F2 ПО ХАРАКТЕРНЫМ ТОЧКАМ МАКСИМУМОВ СЛОЁВ И МИНИМУМОВ ДОЛИН

Гринченко С.В.

Институт ионосферы НАН и МОНМС Украины, г. Харьков

Для создания эмпирической модели электронной концентрации по экспериментальным данным радара некогерентного рассеяния является актуальным построение профиля электронной концентрации по опорным точкам. Представленный алгоритм даёт возможность построения высотной зависимости электронной концентрации нижней части ионосферы по высотам h_mE , h_mF1 , h_mF2 максимумов концентрации электронов слоёв E, F1, F2, высотам h_vE , h_vF1 минимумов электронной концентрации долин слоёв E, F1, а также соответствующим значениям $n_{em}E$, $n_{em}F1$, $n_{em}F2$, $n_{ev}E$, $n_{ev}F1$ концентрации электронов. Приведенный график $n_e(h)$ характеризуется следующими значениями входных параметров: $h_mE = 110$ км, $h_mF1 = 180$ км, $h_mF2 = 260$ км, $h_vE = 120$ км, $h_vF1 = 190$ км, $lgn_{em}E = 4.1$, $lgn_{em}F1 = 5.4$, $lgn_{em}F2 = 5.8$, $lgn_{ev}E = 3.9$, $lgn_{ev}F1 = 5.35$ ($[n_e] = \text{см}^{-3}$):

